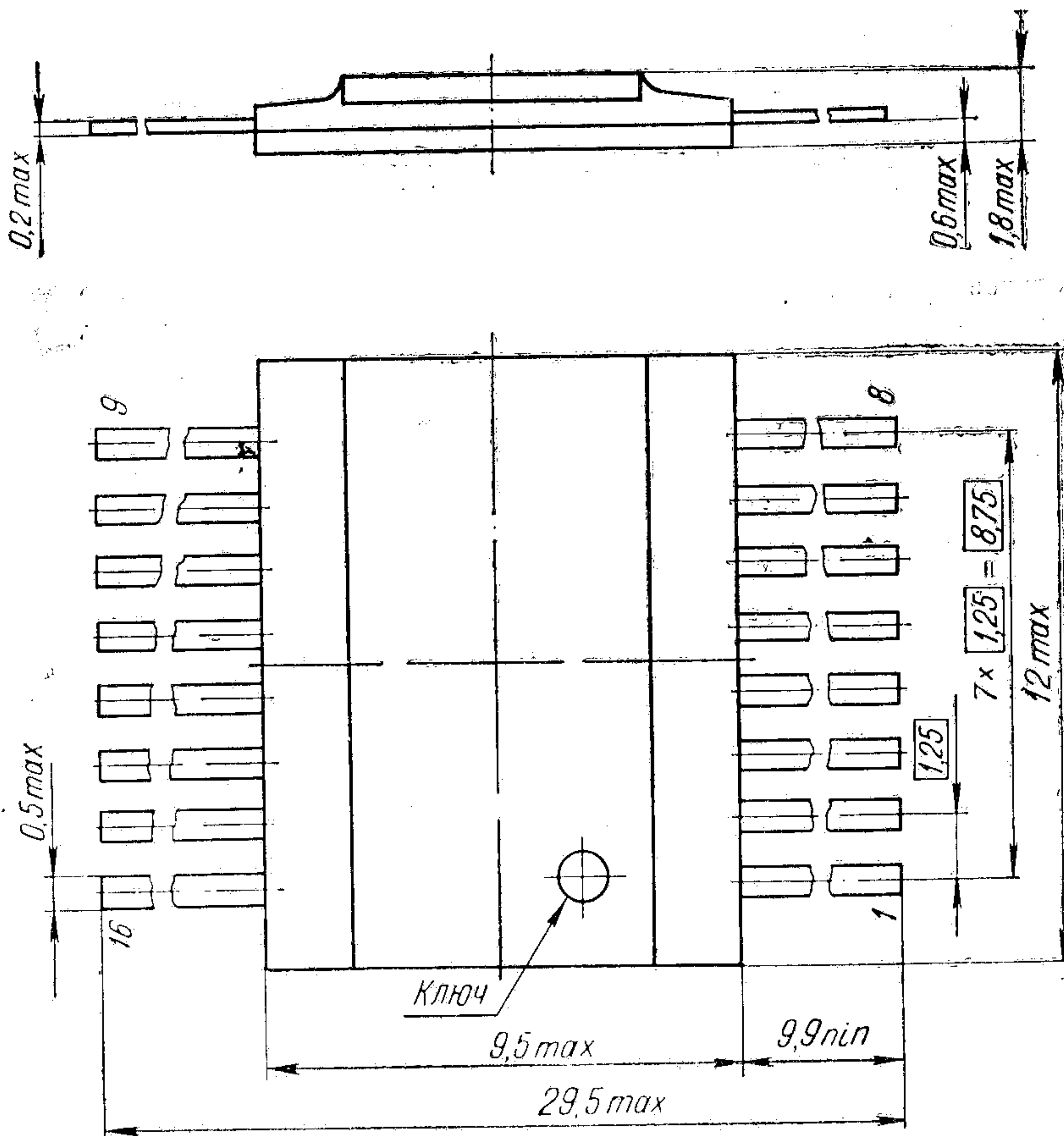


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 318

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 0,5 г

Форма ключа не регламентируется.

Нумерация выводов микросхем показана условно.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 318

Общие данные

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:		
диапазон частот, Гц		от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)		400 (40)
Механический удар одиночного действия:		
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)		10 000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс		от 0,1 до 2,0
Механический удар многократного действия:		
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)		1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс		от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)		5000 (500)
Акустический шум:		
диапазон частот, Гц		от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ		170
Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)		10^{-6} ($1,3 \cdot 10^{-4}$)
Атмосферное повышенное давление, атм		3
Повышенная температура среды, $^{\circ}\text{C}$		85
Пониженная температура среды, $^{\circ}\text{C}$		минус 60
Изменения температуры среды, $^{\circ}\text{C}$		от минус 60 до +85
Иней, роса.		
Соляной туман.		
Среда, зараженная плесневыми грибами.		

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ^О , ч	25 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

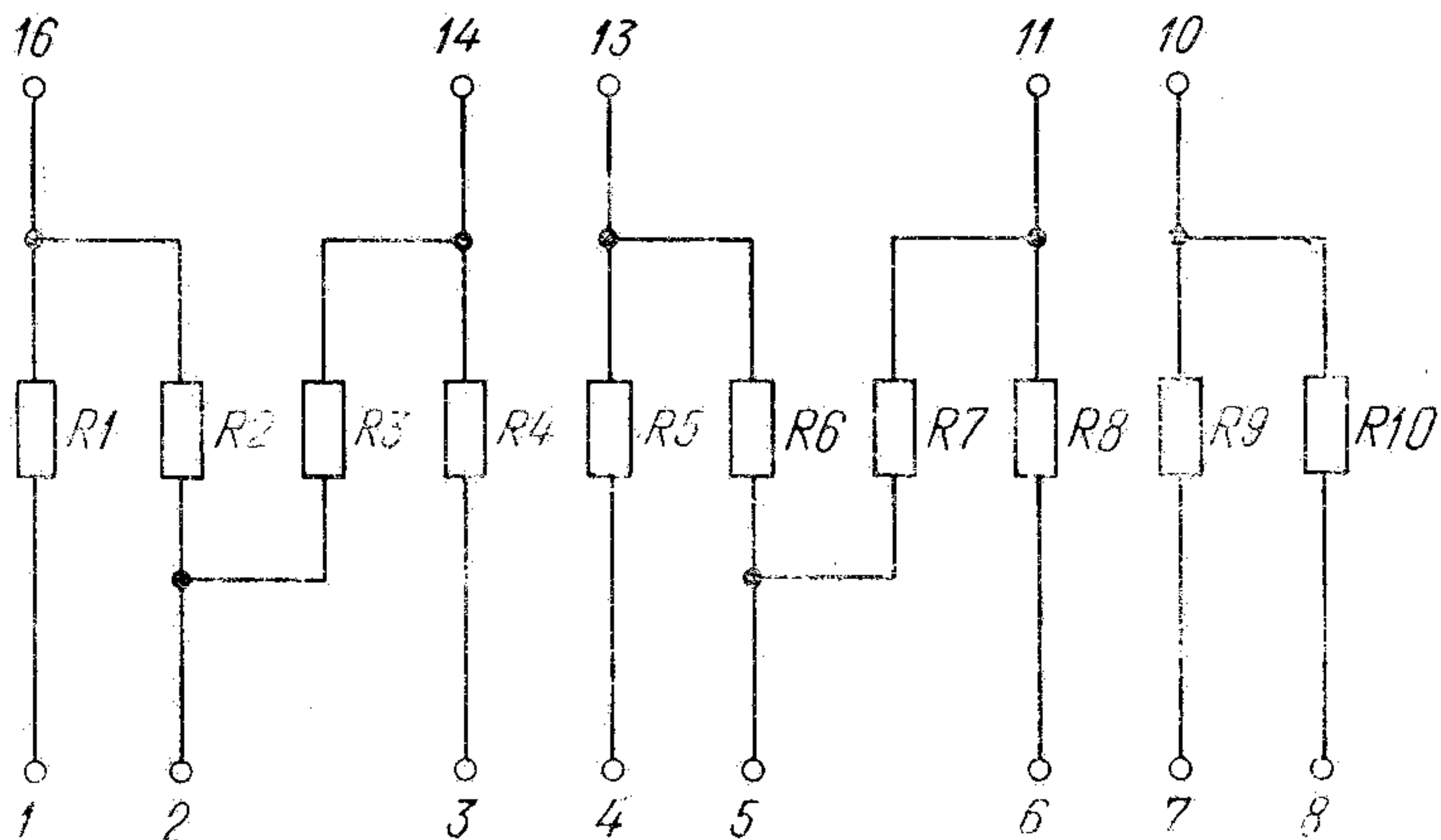
Допустимое значение статического потенциала 100 В.

Микросхемы разрешается применять в аппаратуре любого климатического исполнения.

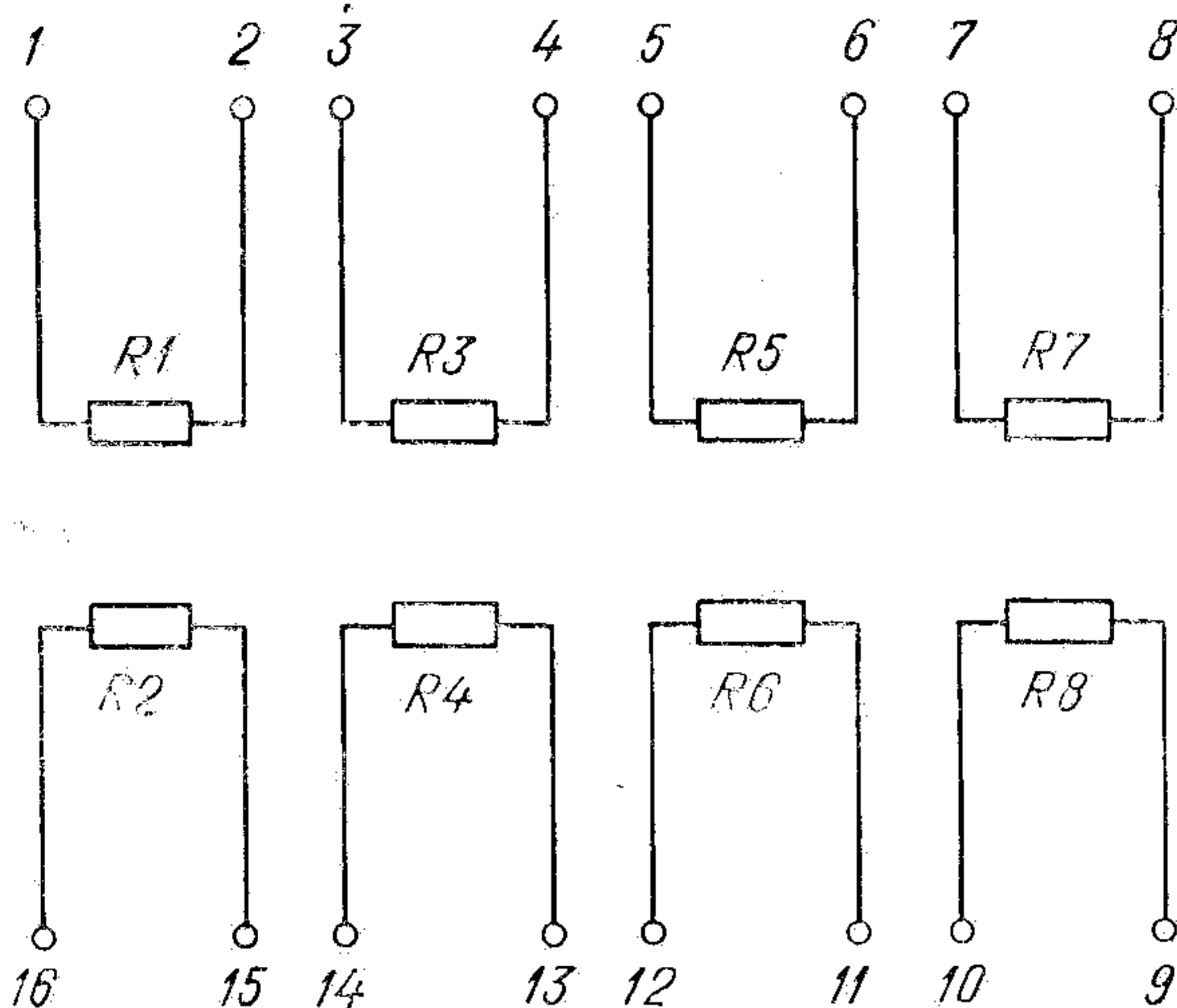
При распайке микросхем на плату расстояние от корпуса до места пайки (по длине выводов) должно быть не менее 2 мм. Допускается трехкратная перепайка выводов микросхем без повторной формовки выводов.

ОВ условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
МИКРОСХЕМ 318НР1, 318НР12



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
МИКРОСХЕМ 318НР2, 318НР3, 318НР4, 318НР5, 318НР6, 318НР7, 318НР8,
318НР9, 318НР10, 318НР11, 318НР13, 318НР14, 318НР15



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(при температуре 25±10°C)

Сопrotивление изоляции (100 В между корпусом и закороченными выводами), МОм	1000
Относительное изменение сопротивления резисторов от первоначального значения, %	±1

Значения сопротивления резисторов

Тип микросхемы	Позиционное обозначение	Номиналь- ное значе- ние сопро- тивления, Ом	Предельное отклонение, %	Номинальная мощность распеи- вания, Вт	
				резистора	микросхемы
318HP1	<i>R1, R4, R5, R8, R9</i>	82	±0,82	0,1	0,6
	<i>R2, R3, R6, R7, R10</i>	130	±1,3	0,15	
318HP2	<i>R1</i>	50	±0,5	0,05	0,4
	<i>R2—R8</i>	100	±1,0		
318HP3	<i>R1, R2</i>	50	±0,5		
	<i>R3—R8</i>	100	±1,0		
318HP4	<i>R1—R3</i>	50	±0,5		
	<i>R4—R8</i>	100	1,0		
318HP5	<i>R1—R4</i>	50	±0,5		
	<i>R5—R8</i>	100	±1,0		
318HP6	<i>R1—R5</i>	50	±0,5		
	<i>R6—R8</i>	100	±1,0		
318HP7	<i>R1—R6</i>	50	±0,5		
	<i>R7, R8</i>	100	±1,0		
318HP8	<i>R1—R7</i>	50	±0,5		
	<i>R8</i>	100	±1,0		
318HP9	<i>R1—R8</i>	50	±0,5		

Продолжение

Тип микросхемы	Позиционное обозначение	Номиналь- ное значе- ние сопро- тивления, Ом	Предельное отклонение, %	Номинальная мощность рассеи- вания, Вт	
				резистора	микросхемы
318НР10 318НР11	<i>R1—R8</i>	100	±1,0	0,05	0,4
	<i>R1—R8</i>	75	±0,75		
318НР12	<i>R1, R4, R5, R8, R9</i>	43	±0,43	0,09	0,6
	<i>R2, R3, R6, R7, R10</i>	240	±2,4	0,01	
318НР13	<i>R1—R8</i>	68	±6,8	0,05	0,4
318НР14	<i>R1—R8</i>	200	±2,0	0,05	0,4
318НР15	<i>R1—R8</i>	510	±5,1	0,05	0,4

По формуле подсчитываются

$$U_{\text{ном}} = \sqrt{P_{\text{ном}}R_{\text{ном}}} \text{ В,}$$

где $U_{\text{ном}}$ — номинальное напряжение, подаваемое на резистор;
 $P_{\text{ном}}, R_{\text{ном}}$ — номинальные значения мощности рассеивания и сопротивления ре-
зистора соответственно.

$$U_{\text{пред}} = \sqrt{P_{\text{пред}}R_{\text{ном}}} \text{ В,}$$

где $U_{\text{пред}}$ — предельно допустимое напряжение, подаваемое на резистор;
 $P_{\text{пред}}$ — предельно допустимая мощность рассеивания.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предельно допустимая мощность рассеивания, мВт:	
для микросхем 318НР1, 318НР12	1250
» » 318НР2—318НР11, 318НР13— 318НР15	1000